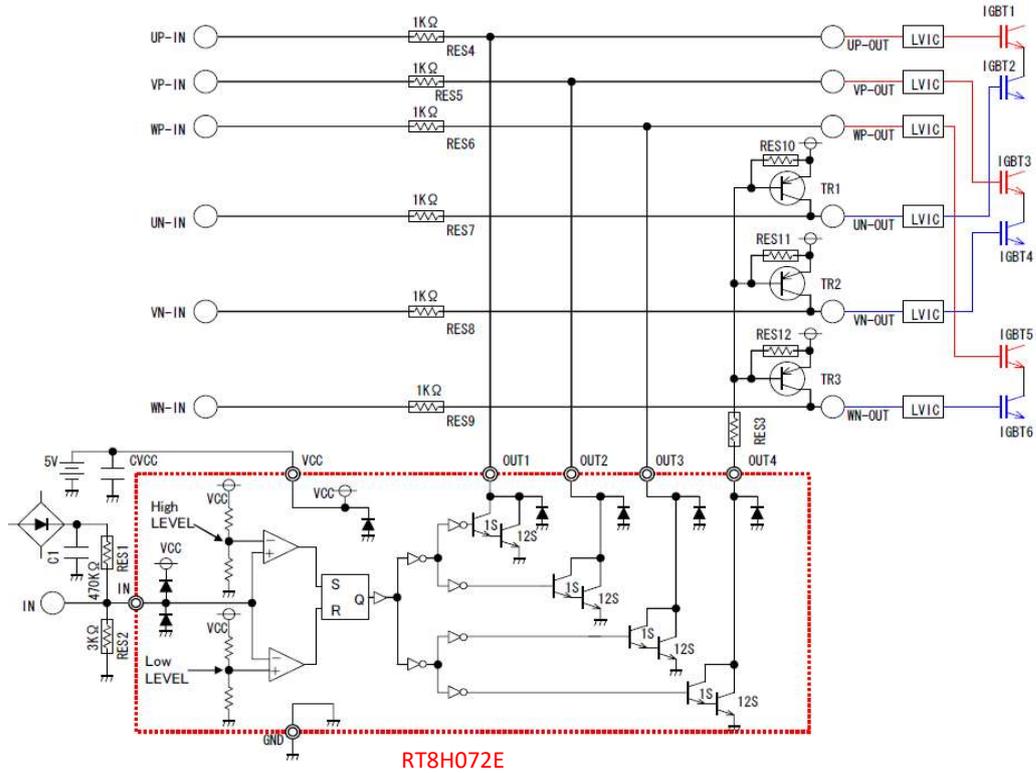


RT8H072E 応用技術資料

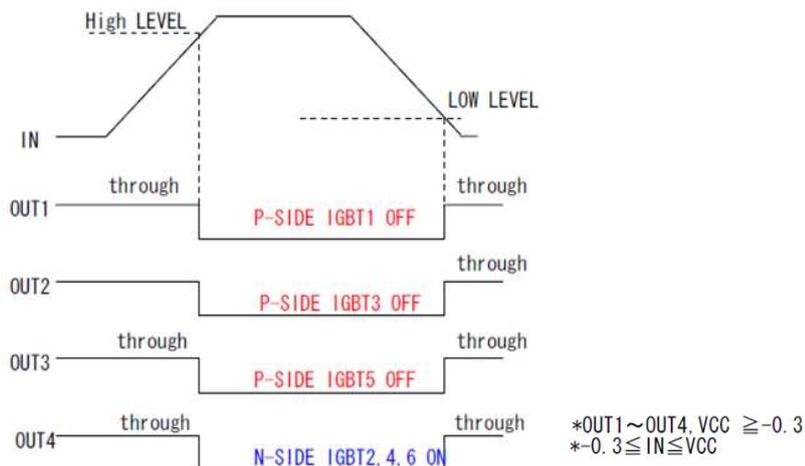
IGBTゲート遮断回路

ブロック図及び応用回路例



* 赤枠内で囲まれた部分が本製品のブロック図となります。

タイミングチャート&動作説明



IN端子電圧がHigh LEVELに達した場合にはOUT1~4端子はLOWとなる。これによって、OUT端子1, 2, 3から接続されるP-SIDEのIGBTはOFFとなり、OUT端子4から接続されるN-SIDEのIGBTはONとなる。この状態はIN端子電圧がHigh LEVELよりも再度下回った場合においても、LOW LEVEL以上であれば保持される。

IN端子電圧がLOW LEVELを下回った場合には、OUT1~4端子電圧はHIGHとなる。これによって、P-SIDEのIGBTはONとなり、N-SIDEのIGBTはOFFとなる。この状態はIN端子電圧がLOW LEVELよりも再度上回った場合においても、High LEVEL以下であれば保持される。